

NE3520S03 FET 产品技术规格

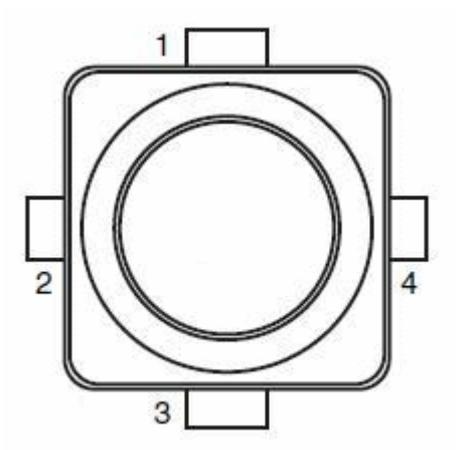
特性

- 推荐偏置条件: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$
- 杂音指数 (NF): 0.65 dB TYP. (@f = 20 GHz)
- 相关增益 (Ga): 13.5 dB TYP. (@f = 20 GHz)
- 封装: 4-pin micro-X plastic hollow package(S03)
- 无铅品

应用

- Ka 带(20 GHz 带)卫星直播信号接收 LNB (LNB: Low noise block converter)
- 其他, 例如 K 带低杂音增幅器

端子连接图



1. Source
2. Drain
3. Source
4. Gate